

대한민국 특허청

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto
is a true copy from the records of the Korean Intellectual
Property Office.

출원번호 : 10-2002-0077969
Application Number

출원년월일 : 2002년 12월 09일
Date of Application DEC 09, 2002

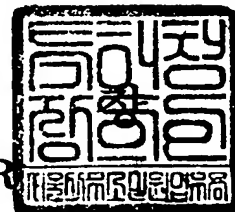
출원인 : 주식회사 하이닉스반도체
Applicant(s) Hynix Semiconductor Inc.



2003 년 05 월 29 일

특 허 청

COMMISSIONER



**【서지사항】**

【서류명】	특허출원서
【권리구분】	특허
【수신처】	특허청장
【참조번호】	0003
【제출일자】	2002.12.09
【발명의 명칭】	반도체소자의 소자분리막 형성방법
【발명의 영문명칭】	Method for manufacturing STI of semiconductor device
【출원인】	
【명칭】	주식회사 하이닉스반도체
【출원인코드】	1-1998-004569-8
【대리인】	
【성명】	강성배
【대리인코드】	9-1999-000101-3
【포괄위임등록번호】	1999-024436-4
【발명자】	
【성명의 국문표기】	이준현
【성명의 영문표기】	LEE, Joon Hyeon
【주민등록번호】	711227-1227224
【우편번호】	361-111
【주소】	충청북도 청주시 흥덕구 신봉동 주공 아파트 109동 304호
【국적】	KR
【심사청구】	청구
【취지】	특허법 제42조의 규정에 의한 출원, 특허법 제60조의 규정에 의한 출원심사를 청구합니다. 대리인 강성배 (인)
【수수료】	
【기본출원료】	17 면 29,000 원
【가산출원료】	0 면 0 원
【우선권주장료】	0 건 0 원
【심사청구료】	7 항 333,000 원
【합계】	362,000 원
【첨부서류】	1. 요약서·명세서(도면)_1통

【요약서】**【요약】**

본 발명은 반도체소자의 소자분리막 형성방법에 관한 것으로, 반도체기판상에 형성된 패드질화막 및 패드산화막을 일부 식각하여 상기 반도체기판을 노출시키는 단계; 상기 노출된 반도체기판내에 불순물을 이온주입하여 불순물 이온주입부를 형성하는 단계; 상기 결과물의 상부에 스페이서용 물질층을 형성한 후 이를 식각하여 상기 패드질화막의 측면에 스페이서를 형성함과 동시에 상기 이온주입부를 제거하여 상기 스페이서 아래에만 이온주입부를 잔류시키는 단계; 상기 이온주입부가 제거된 반도체기판 부분을 식각하여 트렌치를 형성하는 단계; 상기 스페이서를 제거한 후 상기 결과물의 전체 상부에 어닐링공정을 수행하는 단계; 상기 트렌치 표면에 산화막을 형성하는 단계; 상기 결과물의 상부에 평탄화용 산화막을 형성하여 상기 패드질화막과 상기 평탄화용 산화막을 평탄화하는 단계; 및 잔류하는 상기 패드산화막과 상기 패드질화막을 제거하여 소자분리막을 형성하는 단계를 포함하여 구성된다.

【대표도】

도 2j

【명세서】

【발명의 명칭】

반도체소자의 소자분리막 형성방법{Method for manufacturing STI of semiconductor device}

【도면의 간단한 설명】

도 1은 일반적인 반도체소자의 소자분리막을 도시한 공정 단면도.

도 2a 내지 도 2j는 본 발명에 따른 반도체소자의 소자분리막 형성방법을 도시한 공정별 단면도.

(도면의 주요부분에 대한 부호설명)

100 : 실리콘기판 120 : 패드산화막

140 : 패드질화막 140a : 잔류패드질화막

150 : 포토레지스트 180, 180a : 이온주입부

180b : 잔류이온주입부 200 : 제 1 TCR 폴리머 스페이서

220 : 제 2 TCR 폴리머 스페이서 240 : 트렌치

260 : SAC산화막 280a : 잔류 산화막

【발명의 상세한 설명】**【발명의 목적】****【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】**

- <10> 본 발명은 반도체소자의 소자분리막 형성방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 소자분리막 형성공정의 에지 모트형성을 방지하는 반도체소자의 소자분리막 형성방법에 관한 것이다.
- <11> 일반적으로, 반도체기술의 진보와 더불어 더 나아가서는 반도체소자의 고속화, 고집적화가 진행되고 있고, 이에 수반해서 패턴에 대한 미세화의 필요성이 점점 높아지고 있으며, 패턴의 치수도 고정밀화가 요구되고 있다. 이는 반도체소자에 있어서, 넓은 영역을 차지하는 소자분리영역에도 적용된다.
- <12> 현재의 반도체장치의 소자분리막으로는 로코스(LOCOS) 산화막이 대부분 이용된다. 이러한 로코스방식의 소자분리막은 기판을 선택적으로 국부산화하여 얻어진다.
- <13> 그러나, 상기 로코스방식의 소자 분리막은 그 가장자리 부분에 새부리 형성의 버즈비크가 발생하여, 소자분리막의 면적을 증대시키면서 누설전류를 발생시키는 단점을 갖는다.
- <14> 따라서, 종래에는 적은 폭을 가지며, 우수한 소자분리 특성을 갖는 STI(Shallow Trench Isolation)방식의 소자분리막이 제안되었다.
- <15> 일반적으로, 도 1에 도시된 바와 같이, STI공정은 반도체기판(5)상에 패드산화막, 패드질화막을 형성한 다음, 소자분리마스크 및 식각을 진행하고, 상기 소자분리마스크를 이용하여 하부의 반도체기판을 소정깊이 만큼 식각하여 트렌치(17)를 형성한다. 이어서,

상기 트렌치의 측벽을 희생산화 및 측벽산화시키고 전면에 라이너산화막을 형성한 다음, 필드산화막으로서 고밀도플라즈마 산화막을 형성하고 치밀화를 진행한다. 이어 화학적기계적연마공정을 실시하여 상기 트렌치에 매립되는 필드산화막(20)을 형성하고 패드질화막을 스트립한다.

<16> 이어서, 게이트산화막의 증착 전에 HF 또는 HF/H₂O, BOE(Buffer Oxide Etchant)등으로 세정공정을 진행한다.

<17> 즉, 게이트산화막 증착은 반도체 트랜지스터 특성에 아주 중요한 공정이므로 게이트산화막 증착전의 잔류 이물질을 HF 또는 혼합된 불산(HF)등으로 제거한 다음 게이트산화막을 증착한다.

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

<18> 그러나, 이러한 세정공정을 진행하면서 에지 모트(moat)현상이 발생되는데, 이러한 에지모트가 발생하면 소자특성상 험프 및 INWE (Inverse Narrow Width Effect)가 발생하여 반도체소자의 비정상적인 동작을 유발시키는 문제점이 있다.

<19> 따라서, 본발명은 상기 종래기술의 제반문제점을 해결하기 위하여 안출한 것으로서, 트렌치의 코너 라운딩을 극대화시키고 험프 및 INWE등의 소자 특성을 개선할 수 있는 반도체소자의 소자분리막 형성방법을 제공함에 그 목적이 있다.

【발명의 구성 및 작용】

<20> 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 반도체기판상에 형성된 패드질화막 및 패드산화막을 일부 식각하여 상기 반도체기판을 노출시키는 단계; 상기 노출된 반도체기판내에 불순물을 이온주입하여 불순물 이온주입부를 형성하는 단계; 상기 결과물의 상부에

스페이서용 물질층을 형성한 후 이를 식각하여 상기 패드질화막의 측면에 스페이서를 형성함과 동시에 상기 이온주입부를 제거하여 상기 스페이서 아래에만 이온주입부를 잔류시키는 단계; 상기 이온주입부가 제거된 반도체기판 부분을 식각하여 트렌치를 형성하는 단계; 상기 스페이서를 제거한 후 상기 결과물의 전체 상부에 어닐링공정을 수행하는 단계; 상기 트렌치 표면에 산화막을 형성하는 단계; 상기 결과물의 상부에 평탄화용 산화막을 형성하여 상기 패드질화막과 상기 평탄화용 산화막을 평탄화하는 단계; 및 잔류하는 상기 패드산화막과 상기 패드질화막을 제거하여 소자분리막을 형성하는 단계를 포함하여 구성됨을 특징으로 한다.

<21> (실시예)

<22> 이하, 첨부된 도면에 의거하여 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하도록 한다.

<23> 먼저, 도 2a에 도시된 바와 같이 실리콘기판(100)상에 패드산화막(120)과 패드질화막(140)을 형성한 후 포토레지스트(150)를 도포하여 패터닝한다.

<24> 그 다음, 도 2b에 도시된 바와 같이 상기 패터닝된 포토레지스트(150)를 마스크로 하여 상기 패드질화막(140)과 상기 패드산화막(120)을 LOCOS(LOCal Oxidation of Silicon) 건식식각하여 상기 실리콘기판(100)을 소정부분 노출시킨다.

<25> 이어서, 도 2c에 도시된 바와 같이 상기 결과물의 상부에 인(P) 또는 붕소(B)를 얇은 깊이로 이온주입하여 상기 노출된 실리콘 기판(100)내에 불순물 이온주입부(180)를 형성한다.

- <26> 여기서, 상기 이온주입공정은 종래에 반도체공정에서 이용하고 있는 5가의 인(P)과 3가의 붕소(B)를 이용하여 이온주입하여 실리콘(Si)과 인(P)의 결합구조 또는 실리콘(Si)과 붕소(B)의 결합구조를 갖게된다.
- <27> 이러한 이온주입공정은 후속의 SAC(Self Alignment Contact)산화공정에서 불순물 포함안된 실리콘기판(즉, 이온주입이 안된 패드질화막(140) 아래의 실리콘기판) 보다 불순물 포함된 실리콘 기판(즉, LOCOS 건식식각에 의해 노출된 실리콘기판)의 산화속도를 3배 정도 더 빠르게 산화시키기 위한 것이다.
- <28> 또한, 3가의 붕소 보다 5가의 인을 이온주입한 경우 상기 실리콘기판(100)은 더 빠르게 산화되므로 인을 이온주입한다. 이때, 5가의 인 대신 3가의 붕소를 사용해도 되며 또한 3가의 붕소 또는 5가의 인에 한정하지 않아도 된다. 그 불순물 이온주입하는 이유가 상기 실리콘기판의 산화시 불순물의 합류에 의해 실리콘 결합구조가 쉽게 분리하기 위한 것이기 때문이다.
- <29> 그 다음, 도 2d에 도시된 바와 같이, 상기 패드질화막(140) 측벽에 스페이서용 폴리머를 형성하면서 TCR 건식식각하여 잔류 이온주입부(180a)를 형성함과 동시에 폴리머 스페이서(200)를 형성한다. 이때, CHF_3 , CF_4 , Ar 또는 CxFy 의 혼합가스로 이루어진 활성화된 플라즈마를 이용하여 수행하며, N_2 , H_2 등의 가스도 포함할 수 있다.
- <30> 여기서, 상기 잔류 이온주입부(180a)를 상기 폴리머 스페이서(200)의 하부영역 만큼 잔류시키는 이유는 후속의 수소진공 어닐링 공정시 상기 잔류이온주입부(180a)의 실리콘이 이온주입 안된 부위의 실리콘 보다 더 많이 플로우(flow)시키기 위한 것이다. 이는 나중에 에지 모트를 방지하는 중요한 요인이 된다.

- <31> 이러한 TCR 건식식각은 플루오르 함유된 가스를 주요 가스성분으로 하며, 다수의 단계로 나누어 TCR건식식각을 진행하는 것이 라운딩에 더욱 효과적이다.
- <32> 이러한 다수의 단계로 나누어진 TCR건식식각을 설명하면 다음과 같다.
- <33> 먼저, 상기 패드질화막의 측벽에 제 1 스페이서용 폴리머를 형성하면서 제 1 TCR(Top Corner Rounding)건식식각하여 제 1 폴리머 스페이서를 형성한다. 이때, 상기 제 1 TCR 건식식각에서는 플루오르(F) 레이트를 적게 사용하여 식각한다.
- <34> 이어서, 상기 제 2 스페이서용 폴리머를 형성하면서 제 2 TCR 건식식각하여 상기 제 1 폴리머 스페이서의 측면상에 제 2 폴리머 스페이서를 형성한다.
- <35> 이때, 마지막 TCR 건식식각 단계에서는 상기 이온주입부(180a)를 전부식각하고 실리콘도 소정두께 만큼 식각되기 때문에 상기 제 1 폴리머 스페이서와 상기 제 2 폴리머 스페이서 사이의 상기 잔류 이온주입부는 평탄하지 않고 약간 라운딩된다.
- <36> 이때, 상기 제 2 TCR 건식식각은 상기 제 2 TCR 건식식각은 플루오르(F) 레이트를 많이 사용하여 식각한다. 즉, 플루오르 레이트를 증가시키면서 TCR 건식식각하면 제 2 폴리머 스페이서(220)는 증가함과 동시에 TCR건식식각이 진행된다. 이렇게 제 2 폴리머 스페이서(220)를 증가시키면서 TRC 건식식각하면 실리콘기판(100)은 라운딩된다.
- <37> 또한, 상기 제 1 TCR 건식식각과 제 2 TCR 건식식각의 순서를 뒤바꾸어 수행할 수도 있다. 이때, 상기 제 1 TCR 건식식각 단계에서 플루오르(F) 레이트를 많이 사용하고, 상기 제 2 TCR 건식식각 단계에서는 플루오르(F) 레이트를 적게 사용하여도 동일한 효과를 얻을 수 있으며, 그리고 마지막 TCR 건식식각 단계에서는 상기 이온주입부(180a)를 전부식각한다.

- <38> 그 다음, 도 2e에 도시된 바와 같이 상기 실리콘기판(100)을 소정깊이 만큼 식각하여 트렌치(240)를 형성한다.
- <39> 이때, 상기 트렌치 형성을 위한 식각시에도 상기 TCR 폴리머 스페이서(200)의 배리어에 의해 그 하부의 이온주입부의 실리콘은 식각되지 않는다. 또한 이러한 건식식각은 HBr, Cl₂, O₂, H₂등의 혼합가스로 이루어진 활성화된 플라즈마를 이용함으로써, 상기 잔류 이온주입부(180a)에만 이온주입 실리콘이 남겨지고 상기 잔류이온주입부(180a)의 표면부분(A)과 상기 트렌치(240)의 상부 모서리부분(A)이 라운딩된다
- <40> 이어서, 세정공정을 통해 HF 또는 H₂SO₄가 포함된 용액으로 상기 TCR 폴리머 스페이서(200)를 제거하면 상기 잔류이온주입부(180a)만이 남게 된다.
- <41> 그 다음, 도 2f에 도시된 바와 같이, 상기 결과물의 전체 상부에 고온의 수소진공 어닐링공정을 수행한다.
- <42> 이러한 수소진공 어닐링 공정을 거치면, 수소(H)와 실리콘(Si)이 반응하여 Si=Si의 결합구조의 결합력이 떨어지고, 불안정한 결합구조인 H=Si의 결합구조를 갖게 되어 수소와 실리콘의 결합구조가 쉽게 분리되는 불안정한 에너지 상태에 놓이게 된다.
- <43> 이때, 불안정한 에너지 상태에서 안정된 에너지 상태로 전환하려는 성질이 발생하게 되어 트렌치(240)의 상부모서리부분(A)과 하부모서리부분(B)이 흐르려는 플로우(Flow)현상이 발생하여 상기 상부모서리부분(A)과 상기 하부모서리부분(B)은 라운딩된다. 이러한 불안정한 에너지 상태는 주로 상기 상부모서리부분(A)과 하부모서리부분(B)에서 발생한다.

- <44> 또한, 상기 이온주입부(180a)의 표면부분(A)은 그 이온주입 결합구조로 인해 단일의 Si=Si의 결합구조를 갖고 있는 영역보다 더욱 불안정하기 때문에 수소 진공 어닐링공정을 진행하게 되면 상기 표면부분(A)의 불안정한 에너지 상태가 더욱 심해져 플로우현상이 더 빨리 발생하고 상기 트렌치(240)의 상부 모서리부분(A)은 더욱 효과적으로 라운딩된다. 이는 후속공정에서 에지모트를 방지하는 중요한 요인이 된다.
- <45> 그 다음, 도 2g에 도시된 바와 같이, 상기 결과물의 상부에 SAC(Sacrification)산화공정을 수행하여 상기 트렌치(240)내에 SAC 산화막(260)을 형성한다.
- <46> 그 다음, 도 2h에 도시된 바와 같이 상기 결과물의 상부에 평탄화용 산화막(280)을 형성하여 상기 트렌치(240)를 채운다.
- <47> 이어서, 도 2i에 도시된 바와 같이 상기 패드질화막(140)을 식각정지막으로 하여 상기 패드질화막(140)과 상기 평탄화용 산화막(280)을 CMP공정에 의해 평탄화시켜 잔류산화막(280a)과 잔류패드질화막(140a)을 형성한다.
- <48> 그 다음, 도 2j에 도시된 바와 같이, 인산 디핑에 의해 잔류하는 상기 패드산화막(120)과 상기 잔류 패드질화막(140a)을 제거함으로써 상기 평탄화용 산화막(280)이 라운딩부분(A) 보다 높은 위치에 있게 된다.
- <49> 최종적으로, 게이트 산화막 증착 전에 HF 세정공정을 진행하여 실리콘 표면에 잔류하고 있는 이물질을 제거하여도 상기 평탄화용 산화막(280)이 라운딩부분(A) 보다 높은 위치에 있으므로 에지 모트 영역이 없는 최종 프로파일을 얻는다.

【발명의 효과】

- <50> 상술한 바와 같이, 본 발명은 트렌치의 코너 라운딩을 극대화시키고 에지 모트현상이 발생하지 않아 소자특성중 험프, INWE등의 특성이 개선된다.
- <51> 한편, 본 발명은 상술한 특정의 바람직한 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변경 실시가 가능할 것이다.



【특허청구범위】

【청구항 1】

반도체기판상에 형성된 패드질화막 및 패드산화막을 일부 식각하여 상기 반도체기판을 노출시키는 단계;

상기 노출된 반도체기판내에 불순물을 이온주입하여 불순물 이온주입부를 형성하는 단계;

상기 결과물의 상부에 스페이서용 물질층을 형성한 후 이를 건식식각하여 상기 패드질화막의 측면에 스페이서를 형성함과 동시에 상기 이온주입부를 제거하여 상기 스페이서 아래에만 이온주입부를 잔류시키는 단계;

상기 이온주입부가 제거된 반도체기판 부분을 식각하여 트렌치를 형성하는 단계;

상기 스페이서를 제거한 후 상기 결과물의 전체 상부에 어닐링공정을 수행하는 단계;

상기 트렌치 표면에 산화막을 형성하는 단계;

상기 결과물의 상부에 평탄화용 산화막을 형성하여 상기 패드질화막과 상기 평탄화용 산화막을 평탄화하는 단계; 및

잔류하는 상기 패드산화막과 상기 패드질화막을 제거하여 소자분리막을 형성하는 단계를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 반도체소자의 소자분리막 형성방법.

【청구항 2】

제 1 항에 있어서, 상기 건식식각은 다수의 건식식각단계로 나누어 수행하는 것을 특징으로 하는 반도체소자의 소자분리막 형성방법.

**【청구항 3】**

제 2 항에 있어서, 상기 다수의 건식식각단계에서 제 2 건식식각의 플루오르 레이트는 제 1 건식식각의 플루오르 레이트 보다 크게 사용하는 것을 특징으로 하는 반도체 소자의 소자분리막 형성방법.

【청구항 4】

제 3 항에 있어서, 상기 제 2 건식식각은 플루오르 레이트를 증가시키면서 건식식각하여 제 2 폴리머 스페이서를 증가시키는 것을 특징으로 하는 반도체소자의 소자분리막 형성방법.

【청구항 5】

제 2 항에 있어서, 상기 다수의 건식식각 단계중 제 1 식각단계에서는 상기 패드질화막의 측벽에 제 1 폴리머 스페이서를 형성하면서 상기 이온주입부를 일부만 제거하고, 최종 식각단계에서는 상기 이온주입부를 전부 제거하여 상기 제 1 및 제 2 폴리머 스페이서 하부에만 상기 이온주입부를 잔류시키는 것을 특징으로 하는 반도체소자의 소자분리막 형성방법.

【청구항 6】

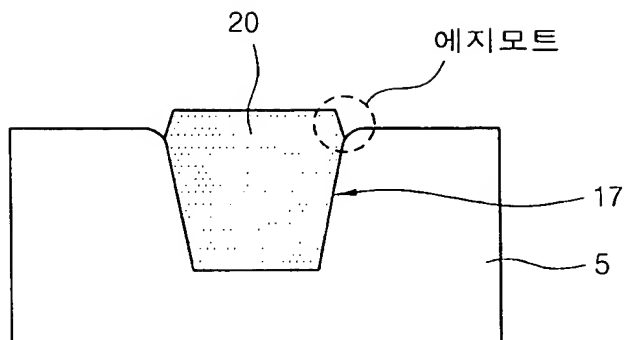
제 1 항에 있어서, 상기 잔류이온주입부는 상기 트렌치 형성을 위한 식각후에도 상기 스페이서의 배리어에 의해 식각되지 않는 것을 특징으로 하는 반도체소자의 소자분리막 형성방법.

【청구항 7】

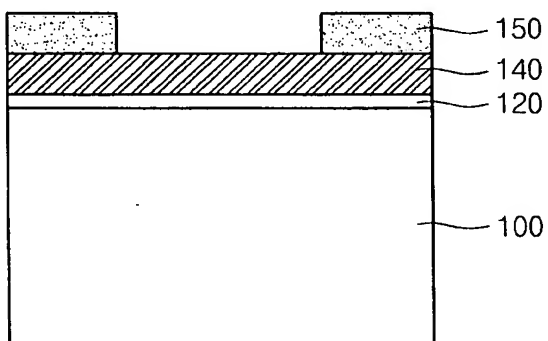
제 1 항에 있어서, 상기 어닐링공정은 상기 트렌치의 상부모서리부분과 하부모서리부분을 라운딩하는 것을 특징으로 하는 반도체소자의 소자분리막 형성방법.

【도면】

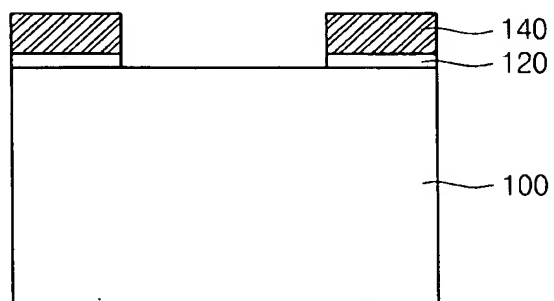
【도 1】



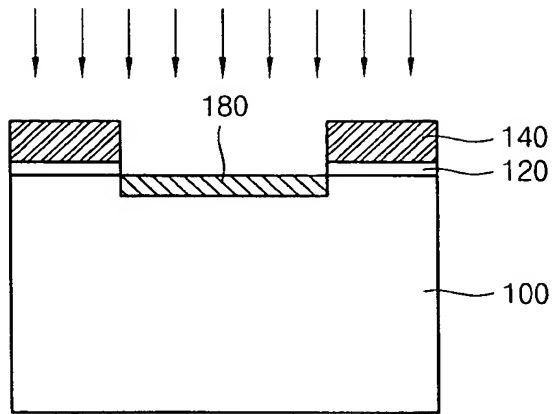
【도 2a】



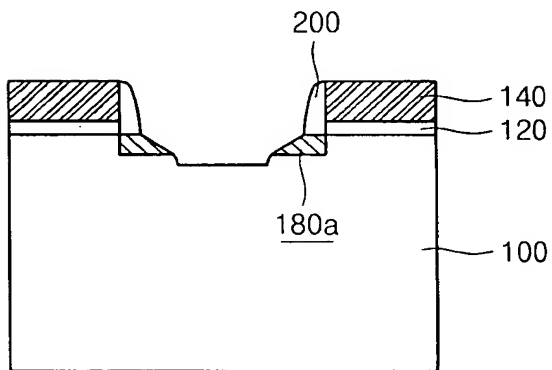
【도 2b】



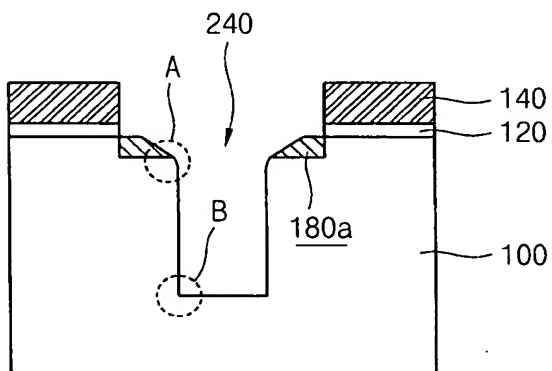
【도 2c】



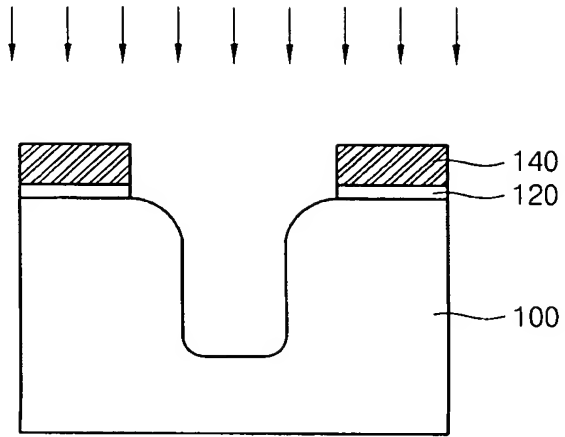
【도 2d】



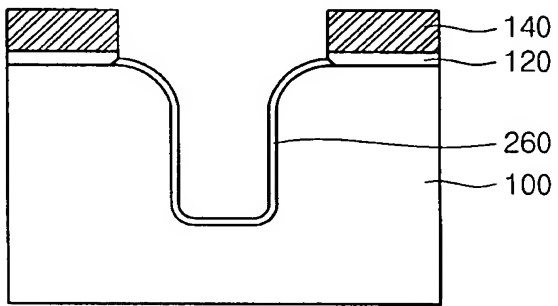
【도 2e】



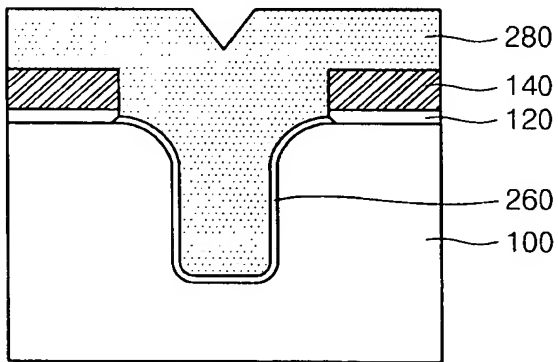
【도 2f】



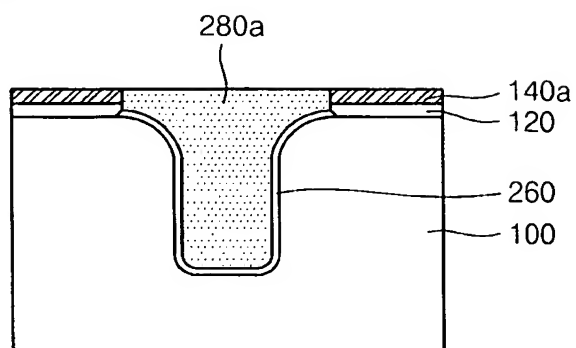
【도 2g】



【도 2h】



【도 2i】



【도 2j】

